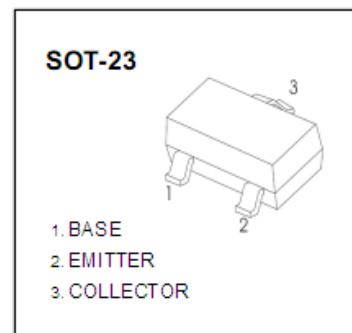




SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors**MMBT3906 (PNP)****印章/Marking : 2A****用途/Applications :**

用于普通放大与开关，与 MMBT3904 互补。

**极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-40	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-40	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_c	-0.2	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_c	0.2	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CBO)}$	$I_c=-10 \mu A, I_E=0$	-40		V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	$I_c=-1mA, I_B=0$	-40		V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EBO)}$	$I_E=-10 \mu A, I_c=0$	-5		V
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-40V, I_E=0$		-0.1	μA
集电极截止电流	I_{CBX}	$V_{CE}=-30V, V_{BE(off)}=-3V$		-50	nA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V, I_c=0$		-0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1V, I_c=-10mA$	100	300	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1V, I_c=-50mA$	60		
直流电流增益	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=-1V, I_c=-100mA$	30		
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_c=-50mA, I_B=-5mA$		-0.4	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_c=-50mA, I_B=-5mA$		-0.95	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=-20V, I_c=-10mA, f=100 MHz$	300		MHz
延迟时间	t_d	$V_{CC}=-3V, V_{BE}=-0.5V,$ $I_c=-10mA, I_{B1}=-I_{B2}=-1.0mA$		35	nS
上升时间	t_r			35	nS
存储时间	t_s	$V_{CC}=-3V, I_c=-10mA,$ $I_{B1}=-I_{B2}=-1.0mA$		225	nS
下降时间	t_f			75	nS



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

典型特性曲线图/Typical Characteristics

